

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



MÔN HỌC ỨNG DỤNG HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP

CBPT: Trần Thiện Thanh

ĐT : 09 08 57 58 51

Email: ttthanh@hcmus.edu.vn

https://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/tranthienthanh/home/tai-lieu-hoc-tap/unhn

HÃY NÓI NHỮNG GÌ CÁC EM ĐÃ BIẾT VỀ MÔN HỌC NÀY??



EM NGHĨ MÌNH SẼ BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ SAU KHI EM HỌC MÔN HỌC NÀY?



MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nguyên lý, quy trình thực hiện, cách bố trí thí nghiệm, hệ đo, thu nhận số liệu.
- Úng dụng trong thực tế của phương pháp truyền qua, tán xạ, đánh dấu đồng vị phóng xạ, chiếu xạ và chụp ảnh phóng xạ

CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mưc độ (I/T/U)
G1.1	Thực hiện đi học đúng giờ, tập trung nghe bài giảng, thực hiện seminar, tìm kiếm tài liệu trên mạng internet	U
G1.2	Thực hiện việc dịch và đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến nội dung môn học	Т
G2.1	Nắm được quy trình bố trí thí nghiệm, thu thập	Т
G2.2	Biểu diễn được số liệu và công thức truyền sai số trong phân tích	U
G3.1	Phân tích được bộ số liệu để xác định nguyên nhân	U, T
G3.2	Thao tác được các thiết bị thí nghiệm	U, T

CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết – hành động)	Mưc độ (I/T/U)
G4.1	Hiểu được các nguyên nhân sai hỏng	Т
G4.2	Giải đoán được các nguyên nhân sai hỏng	Т
G5.1	Phác thảo được các bước tiến hành thí nghiệm của phương pháp NDT	Т
G5.2	Phác thảo được các bước tiến hành thí nghiệm của phương pháp NCS	Т
G5.3	Phác thảo được các bước tiến hành thí nghiệm của phương pháp RT	Т
G5.4	Phác thảo được các bước tiến hành thí nghiệm của phương pháp IR	Т

NỘI DUNG MÔN HỌC

- 1. Giới thiệu môn học-Tương tác của bức xạ với vật chất
- 2. Thiết bị ghi nhận bức xạ-An toàn phóng xạ và liều lượng
- 3. Kiểm tra không phá hủy (NDT)
- 4. Hệ thống kiểm định hạt nhân (NCS)
- 5. Đánh dấu đồng vị phóng xạ (RT)
- 6. Chiếu xạ trong công nghiệp (IR)

LÀM SAO ĐỂ HỌC TỐT QUA MÔN HỌC NÀY?



ĐÁNH GIÁ

BTVN#1: (10%)

BTVN#2: (10%)

Thi giữa kỳ: Tự luận (20%)

Thi cuối kỳ: seminar + vấn đáp (60%)

TÀI NGUYÊN MÔN HỌC

- 1. Radioisotope techniques for problem solving in industrial process plants, J.S. Charlton, Leonard Hill, Glasgow and London, 1986.
- 2. Radioisotope Gauges for Industrial Process Measurements, Geir Anton Johansen and Peter Jackson, John Wiley & Sons, 2004
- 3. An toàn bức xạ ion hóa, Châu Văn Tạo, NXB Đại học quốc gia TpHCM, 2004.
- 4. Technical data on nucleonic gauges, IAEA-TECDOC-1459, 2005.
- 5. Radiotracer Applications in Industry A Guidebook, IAEA-TECDOC 423, 2004
- 6. Radiotracer applications for troubleshooting and optimizing industrial processes, IAEA/RCA in India, 2002.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.

2. Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết và thực hành.

3. Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.

Phân biệt giữa <u>Teamwork</u> và <u>Group</u> discussion?

Group Discussion





BÀI TẬP 1:

Hình thành 5 nhóm học tập (Đặt tên nhóm, thiết kế logo của nhóm và bầu trưởng nhóm)







5W-1H-2C-5M: Phương cách định hướng công việc hoàn hảo

Định hướng nội dung cho một công việc (5W 1H 2C 5M)

- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
- Xác định nội dung công việc 1W (what)
- Xác định 3W: where, when, who
- Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
- Xác định phương pháp kiểm soát 1C (control)
- Xác định phương pháp kiểm tra <u>1C (check)</u>
- Xác định nguồn lực thực hiện <u>5M (man, money, material, machine, method)</u>

Why:

Nghĩa là vì sao bạn làm điều đó, làm điều đó thì sẽ được lợi ích gì. Đây chính là bước bạn xác định mục đích, mục tiêu việc làm của bạn.

Who:

Cần những ai làm điều đó, bạn sẽ làm một mình hay cần ai đó làm cùng, những người đó có thích hợp không

When:

Làm việc đó vào khi nào thích hợp nhất, làm việc đó thì mất bao nhiều thời gian, bạn có đủ thời gian không

Where:

Làm việc đó ở đâu, cần bố trí không gian như thế nào

What:

Làm việc đó thì chúng ta cần những gì

How:

Làm điều đó thì bạn sẽ làm thế nào để dễ dàng thực hiện nhất

How much, how many:

Bạn sẽ mất gì được gì

Control:

Có bao nhiều điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu

Check:

Có những bước công việc nào cần phải kiểm tra. Thông thường thì có bao nhiều công việc thì cũng cần số lượng tương tự các bước phải kiểm tra

Man, Money, Material, Machine, Method:

Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp

BÀI TẬP 2:

Tìm hiểu về phương pháp lập kế hoạch??

TỔNG QUAN



Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing)

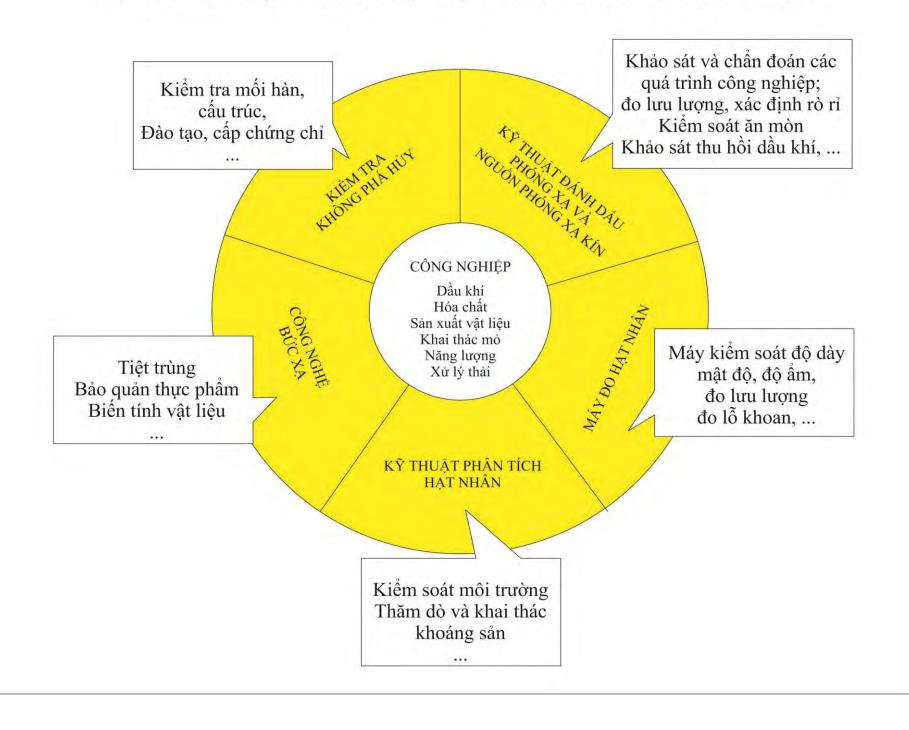
Hệ thống điều khiển hạt nhân (Nucleonic Control System)



Đánh dấu đồng vị phóng xạ (Radioactive Tracer)

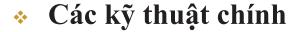
Chiếu xạ công nghiệp (Irradiation)

MỘT SỐ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP



1. Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing)

* Mục đích: Kiểm tra, phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc ở bề mặt kiểm tra của vật thể mà không làm tổn hại đến khả năng sử dụng của chúng



- Kiểm tra siêu âm (Ultrasound Testing UT)
- Kiếm tra chụp ảnh phóng xạ (Radiographic Testing RT)

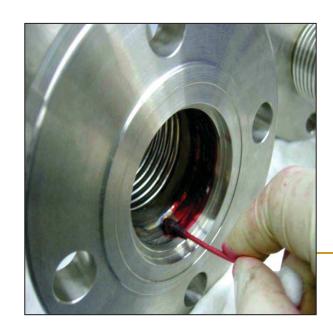
Kiếm tra trực quan từ xa (Remote Visual Inspection –
 RVI)



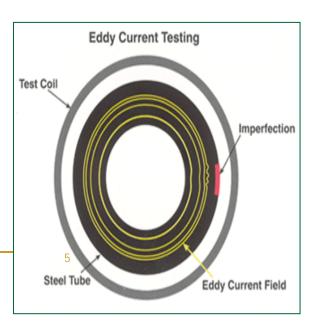


1. Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing)

- Các kỹ thuật chính (tiếp)
- Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (liquid Penetrant Testing PT)
- Kiểm tra bột từ (Magnetic Particle Testing MT)
- Kiểm tra dòng xoáy (providing Eddy current Testing ET)







1. Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing

- Úng dụng
- Khảo sát mật độ vật chất, tình trạng bên trong thiết bị, vật thể
- Xác định vị trí khuyết tật bên trong vật thể
- Kiểm tra chất lượng mối hàn, bề mặt vật đúc
- Khảo sát đường ống: rò rỉ, tắc nghẽn, tạo bọt khí, đóng cặn, tắc nghẽn bên trong đường ống
- Khảo sát phân bố các pha trong thiết bị (đặc biệt là thiết bị nhiệt)







2. Hệ thống điều khiển hạt nhân (Nucleonic Control System)

- Mục đích: Sử dụng như một hệ thống đo (độc lập hoặc tích hợp) trong hệ thống điều khiển để kiểm soát dây truyền sản xuất.
- Các ứng dụng chính: sử dụng trong các ngành như dầu khí, hóa chất, giao thông, xây dựng, năng lượng, xử lý chất thải:
- Hệ thống NCS đo mức (nhà máy bia, nhà máy nước, nhà máy lọc dầu...)
- Hệ thống NCS đo bề dày (nhà máy giấy, nhà máy sản xuất tấm lợp, cửa kính...)

Hệ thống NCS đo mật độ vật chất, phân tích mẫu quặng, đất đá...

Sensor adjusts rollers based on data from detector

Sheet B-particle source

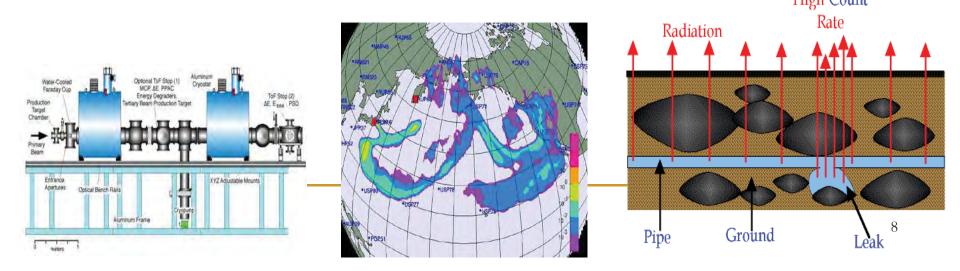
Rollers Sheet source

3. Đánh dấu đồng vị phóng xạ (Radioactive Tracer)

Mục đích: Đưa và theo dõi sự lưu chuyển của chất đánh dấu (đồng vị phóng xạ) trong dòng chảy, trong các quá trình công nghệ, hoặc trong môi trường, giúp phát hiện tính liên tục của dòng chảy, đặc điểm của quá trình công nghệ, đặc điểm của môi trường và các đặc điểm khác.

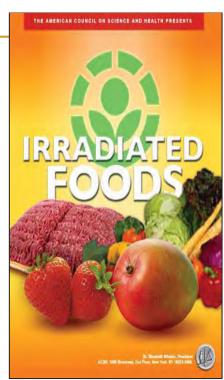
* Các kỹ thuật, ứng dụng chính:

- Kỹ thuật đánh dấu phóng xạ trong khai thác dầu khí
- Kỹ thuật đánh dấu phóng xạ trong dây truyền công nghệ trong công nghiệp
- Kỹ thuật đánh dấu phóng xạ trong nghiên cứu thủy văn, môi trường, kiểm tra chất lượng đập thủy điện
 High Count

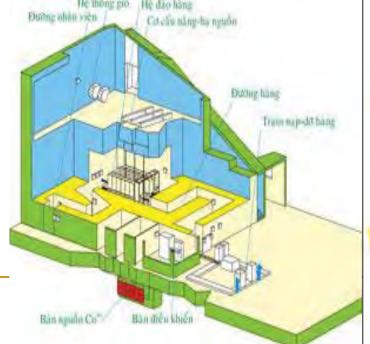


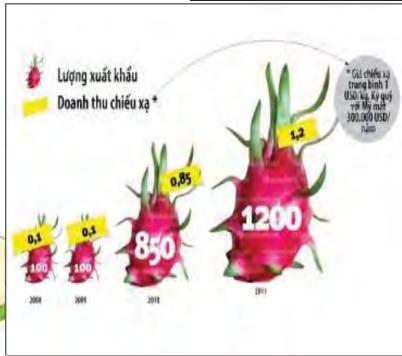
4. Chiếu xạ công nghiệp (IR)

Các kỹ thuật, ứng dụng chính: Khử trùng các sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe, các loại thuốc, chiếu xạ bảo quản thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp (với các mục đích khác nhau diệt côn trùng, làm chậm chín, ức chế nảy mầm, kiểm soát sâu bọ và khử trùng), và làm biến tính vật liệu (polyme hóa, nối mạch polyme, tạo màu cho đá quý...).





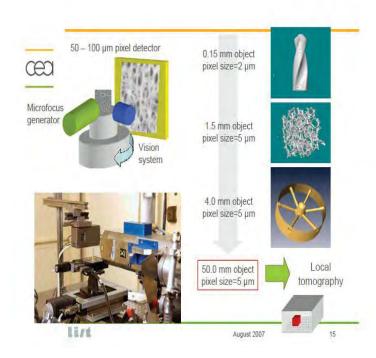




Lợi ích của các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

- Dối với các dây truyền sản xuất, có thể tiến hành kiểm tra khi đang tiến hành sản xuất nên chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc dừng cả hệ thống.
- ► Việc ứng dụng NDT để kiểm tra các công trình xây dựng được không làm ảnh hưởng tới giá trị sử dụng của chúng.
- Lợi ích kinh tế lớn từ các dịch vụ chiếu xạ công nghiệp.
- ▶ Úng dụng cho nghiên cứu cấu trúc, công nghiệp vật liệu.





Các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

- Có mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng, xây dựng, giao thông – vận tải, khai thác khoáng sản...
- Là quy trình bắt buộc trong việc nghiệm thu, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp...
- Nhu cầu đối với các dịch vụ kỹ thuật hạt nhân ngày càng mở rộng, có tiềm năng phát triển to lớn.

BÀI TẬP 3:

- Tương tác của hạt nặng mang điện với vật chất?
- Tương tác của hạt mang điện nhẹ với vật chất?
- Tương tác của photon với vật chất?
- Tương tác của neutron với vật chất?
- Detector ghi bức xạ hạt nhân?
- Các thiết bị hạt nhân cho ứng dụng?

Ra trường sẽ làm gì??









Trang chủ

Công ty APAVE Châu Á - Thái Bình Dương

"THÀNH CÔNG VÀ RỘNG MỚ"

1993: APAVE có mặt tại Đông Nam Á

1996: được Bộ Thương mại cấp giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngåy 25/11

1997: được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài – APAVE Việt Nam & Đông Nam Á













Kiểm tra không phá húv

Advanced NDT

Tubular inspection Giám sát độc lâp

Xử lý nhiệt (Preheat and PWHT)

tao

Purchasing







Phương pháp kiểm tra chup ảnh phóng xa (RT)

Phương pháp kiểm tra siêu âm (UT)

Phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT)

Phương pháp kiểm tra hạt từ (MT)

Vacuum Test (VT)







Your safety and success are Our happiness and pride



GIỚI THIỆ Phương pháp kiểm tra dòng xoáy - ECT

Phương pháp đo đồ cứng (HAT)

Phân tích thành phần hợp kim (PMI)

TUYẾN DUNG

Xem tiếp »



Painting inspection

Kiểm tra lớp phủ (HT)

Visual Inspection

Dư án Biến Đông 1 gồm nhiều hang mục: Chân để & Giàn công nghệ trung tâm Hải Thach , Chân để & Giàn Mộc Tinh 1, cầu dẫn với khoảng 70km đường ống, 20km cáp ngam.





Add(1): 18A Đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Tp HCM Add(2): Số 520, D5 Khu Dân Cư Kiến



CÔNG TY TNHH TƯ VẢN KỸ THUẬT GTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 087/17/TBTD-GTC

Tp.HCM ngày 10 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật GTC là tổ chức hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ cung ứng nhân sự và thiết bị, tư vấn kỹ thuật, giám định - thử nghiệm, quản lý dự án, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Do nhu cầu triển khai các dự án mới, công ty chúng tôi cần tuyển nhân sự mới:

Thông tin tuyển dụng như sau:

· Vị trí tuyến dụng: Kỹ thuật viên & Kỹ sư Kiểm tra không phá hủy (NDT)

Số lượng tuyển dụng: 05 người
 Giới tính: Nam

 Trình độ: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Cơ kỹ thuật, Vật lý hạt nhân, Vật lý ứng dụng.

Kinh nghiệm: Sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, ưu tiên có kinh nghiệm

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

- Thời gian tuyên dụng: đến hết ngày 30/12/2017

- Địa điểm làm việc: thành phố Hồ Chí Minh và các tính thành trong cả nước

- Mức lương: Tùy theo năng lực, sẽ thỏa thuận trực tiếp

Mô tả công việc: Trao đổi cụ thể khi phống vấn

Chế độ:

 Chế độ đối với người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN: theo quy định của nhà nước.



Trang chủ

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) là Trung tâm tiến tiến cung cấp các giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm tra, phát hiện và chân đoán quả trình công nghệ trong sản xuất và đời sống.

CANTI - The Industrial Insight

Mục tiêu của chúng tối là đem đến cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật trong vận hành, bảo dưỡng, khắc phục sự cổ và nâng cấp (OMM) nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí và tiết kiệm thời nian

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

Trung tâm vẫn duy trì được sự phát triển, đạt thêm nhiều thành tích mới, trong đó có những tiến bộ mang tính bước ngoặt, có tiến bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa...



VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY

Center for Non-Destructive Evaluation

Từ khóa tìm kiếm...



TRANG CHŮ Home Page GIỚI THIỆU About NDE TIN TÚ'C - SỰ KIỆN News - Events

DICH VU Our Services NGHIÊN CỬU Research ĐÀO TẠO Training Courses SÂN PHẨM Products LIÊN HỆ Contact Us DIÊN ĐÀN Forum

You are here: Trang chủ \ Nghiên cứu





KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUY (NDT) CÁC BỒN THÉP CHẾ TẠO BẰNG HÀN

Published in Bài báo khoa học Dăng bởi admin

Từ khóa tìm kiếm...
SITE MAP

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức - Sư kiến

Dịch vụ

Nghiên cứu

> Đề tài khoa học

Hoat động nghiên cứu triển khai



TRUNG TÂM NGHIÊN CỚU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BỰC XẠ RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR RADIATION TECHNOLOGY





VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

Hanoi Irradiation Center



DICH VU

- · Chiếu xạ thực phẩm
- Chiếu xạ sản phẩm y tế
- Chiếu xạ nghiên cứu
- · Sản xuất được chất phóng xa

Quy định đăng ký, quy cách bao bì và giá chiếu xạ, kiểm dich hoa quả

Quy định đẳng ký, quy cách bao bì và giá chiếu xạ, kiếm dịch hoa quả Đọc tiếp

TIN TRONG NƯỚC

TIÊU ĐIỂM

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HOC

TT CHIỀU XẠ HÀ NỘI TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ ẤN ĐÔ



LÀM SẠCH SẢN PHẨM

TRANG CHŮ

GIỚI THIỆU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

DỊCH VỤ & SẢN PHẨM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Hỗ TRỢ KHÁCH HÀNG

GIẤY CHỮNG NHẬN

TIN TŮC & SỰ KIỆN

LIÊNHỆ

VIN EN



CHIẾU XẠ TRÁI CÂY TƯỚI

No Image Available

CHO THUỆ CHO THUỆ DỊCH VỤ



TRÁI CÂY TƯỚI



TRÁI CÂY Đồng Lạnh



THUÝ HÁI SẢN ĐỗNG LẠNH



THỰCPHẨM



NÓNG SÁN



MÝ PHẨM



DỤNG CỤ Y TẾ



BÓ



BỘT GIA VỊ

s.hcmus.edu.vn/vlhn/index.php?option=com_content&view=article&id=261:tuy-n-d-ng-c-a-tru-ng-d-i-h-

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN – KỸ THUẬT HẠT NHÂN DEPARTMENT OF NUCLEAR PHYSICS – NUCLEAR ENGINEERING

TRANG CHŮ

NHÂN SƯ

OAT OÁG

NGHIÊN CỨU

PHÒNG THÍ NGHIỆM

HƠP TÁC

THÔNG

SINH VIÊN

THƯ VIỆN

LIÊN HÊ

Thông báo

Tuyển dụng của trường Đại học Y khoa Pham Ngọc Thach

Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cần tuyển hai giảng viên (02) và một (01) kỹ thuật viên với các nội đung như sau:

MUC ĐÍCH

- Giảng đạy Vật lý đại cương và Vật lý Y Sinh cho SV năm nhất khối ĐH Y.
- Nghiên cứu Vật lý hướng đến ứng dụng trong Y Sinh học và Khoa học sự sống.

YÊU CÂU:

- Thạc sĩ chuyên ngành thích hợp hoặc vừa bảo vệ ThS.
- Cử nhân Vật lý hoặc Vật lý Kỹ thuật loại khá trở lên (giành cho giảng viên).
- Ngoại ngữ tối thiểu: Toefl ITP 500 IELTS 5.0 C hoặc trình độ tương đương.
- Tin học: thành thạo MS Office.
- Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và hộ khẩu Tp.HCM là một ưu tiên.
- Sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp ĐH từ các trường sau:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp HCM hoặc ĐHQG HN

Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG Tp HCM hoặc ĐHQG HN

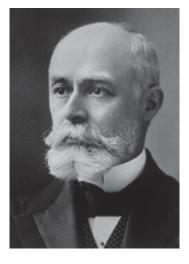
Trường ĐH Sư Phạm Tp HCM hoặc ĐHQG HN

Trường ĐH Công Nghệ - ĐHQG HN

Hồ sơ gồm có: đơn xin việc (Job letter), sơ yếu lý lịch (CV), hộ khẩu, CMND, bằng cấp, chứng chỉ, giấy khám sức khỏe, 01 hình 4x6.

Phát hiện ra phóng xạ









Röntgen 1895

Discovery of X-ray

Becquerel

1896

Pierre & Marie Curie 1898

1938

Hahn

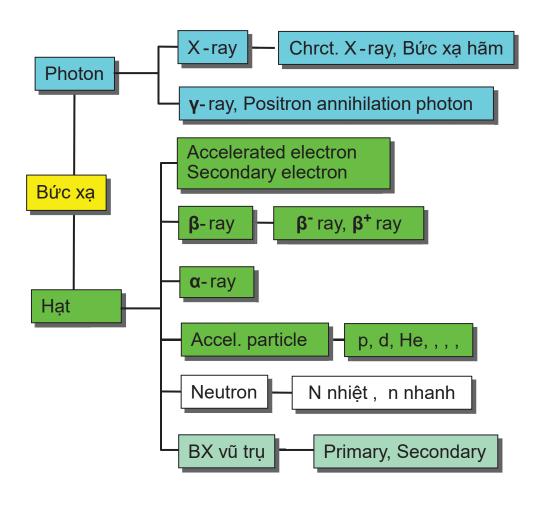
Spontaneous radioactivity

Discovery of Ra, Po

Discovery of fission



Loại bức xạ



Điện tích và Khối lượng nghỉ

Loại	ký hiệu	điện tích	khối lượng
X - ray	Χ	0	0
γ - ray	γ	0	0
Electron	e-	-1	0.00054858
β ⁻ ray	β-	-1	ditto
β+ ray	β ⁺	+1	ditto
Proton	р	+1	1.0072765
Deuteron	d	+1	2.013553
α- ray	α	+2	4.0015061
Neutron	n	0	1.0086650
Fission fragment	FP		80 ~ 108 128 ~ 155

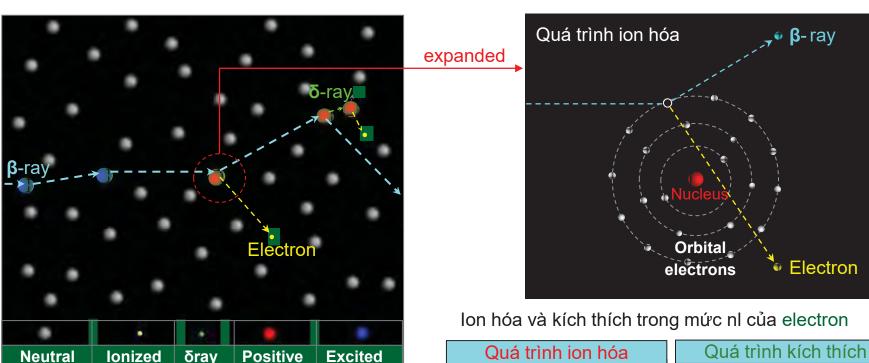
- 1) Điện tích $1e = 1.60219 \times 10^{-19}$ Coulomb
- 2) Đơn vị (u) $1u = 1.66056 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 25

Tương tác của bx với vật chất

Ion hóa và kích thích bởi α- hoặc β-rays Đặc trưng hấp thụ của α-rays Năng suất hãm và quãng chạy của hạt mang điện Đặc trưng hấp thụ của β-rays Năng suất hãm và quãng chạy Hủy positron, hiệu ứng Cherenkov Tương tác của photon với vật chất Phân bố năng lượng của electron thứ cấp Tương tác của neutron với vật chất

lon hóa và kích thích bởi α-hoặc β-rays

α-ray hoặc β-ray mất một phần năng lượng do ion hóa và kích thích vật liệu, và tạo ra các electron và ion dương. Năng lượng trung bình để sinh ra a electron & ion là 25 ~ 40 eV trong khí, và 3 ~ 5 eV trong vật liệu rắn.



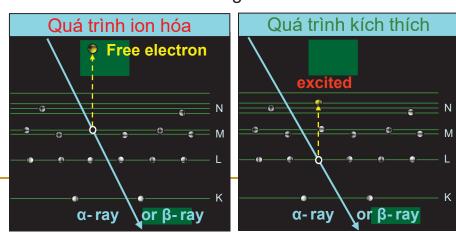
atom

ion

δ- ray là electron mang năng lượng có khả năng ion hóa nguyên tử khác. Nếu nt trung hòa bắt electrong sẽ trở thành ion âm. Cuối cùngm toàn bộ năng lượng bức xạ chuyển thành nhiệt năng.

electron

atom



Đặc trưng hấp thụ của α-rays

KL của hạt α thì nặng hơn 7,300 lần electron. Do đó, đường đi trong vật chất gần như là đường thẳng vì ít khi giật lui khi va chạm với các electron.

Số cặp electron-ion được tao ra do sự ion hóa dọc đường đi được gọi là đường cong Bragg curve, như trong hình.

đường đi α- ray trong không khí

Q chạy (R)

ĐC Bragg của α-rays

KT

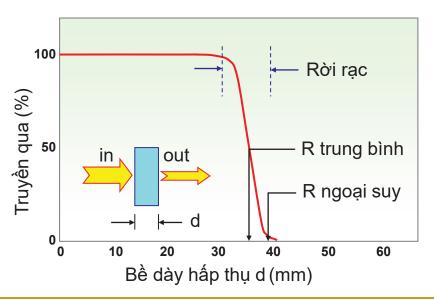
Chiều dài (x)

Đặc trưng hấp thụ của α-rays trong vật chất được chỉ ra bên dưới và quãng chạy (R) trong không khí là một hàm của năng lượngy (E) được cho bởi pt thực nghiệm sau.

$$R = 0.318 E^{3/2}$$

Ví dụ

R = 3.88 cm (tại 1atm, KK) cho E = 5.3 MeV. Quãng chạy của α -rays với NL 5~8 MeV trong Si là 25 ~ 50 μ m.

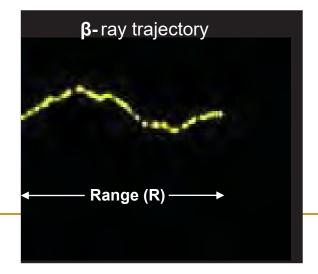


Đường cong hấp thụ và quãng chạy của chùm α-rays hẹp

Đặc trưng hấp thụ của β-rays

β-ray mất một phần năng lượng trong vc bởi quá trình va chạm với electrons trong nguyên tử và bức xạ hãm (Bremsstrahlung) (phát ra X-ray) khi bay gần trường hạt nhân.

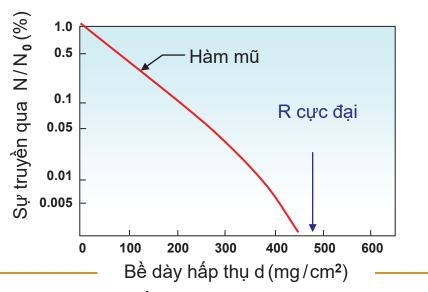
Hướng bay của hạt β se thay đổi sau một va chạm. Đường đi sẽ bị uốn lượn. Thêm vào đó, do phân bố năng lượng là liên tục củaβ-rays, rất khó khăn để xác định chính xác quãng chạy bằng phương pháp đo trực tiếp.



Đặc trưng hấp thụ và quãng chạy của β-rays

Đường cong hấp thụ của β-ray xấp xỉ hàm mũ trong bề dày vật liệu ở đó sự truyền qua không quá nhỏ. Hệ số hấp thụ khối μ_m (cm²·mg-¹) và quãng chạy R(mg/cm²) cho năng lượng cực đại E (MeV) được tính từ nhiều pt thực nghiệm.

$$N/N_0 = \exp(-\mu_m d)$$
 $\mu_m = 0.017 E^{-1.43}$ for Al
 $R = 542 E - 133$ cho $E > 0.8 \, MeV$
 $R = 407 \, E^{1.38}$ cho $0.15 \, MeV < E < 0.8 \, MeV$

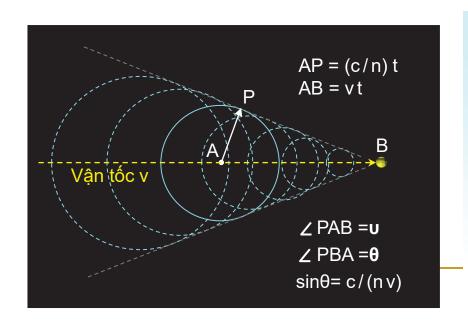


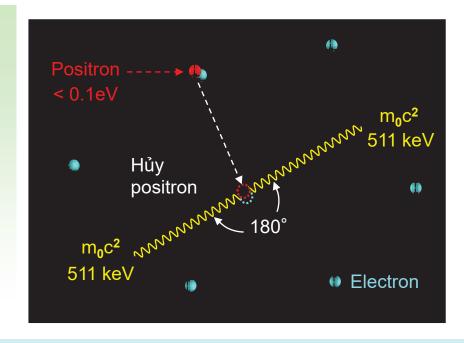
Đường cong hấp thụ và R cực đại của β-ray₂₉

Hủy positron

Khi một positron mất năng lượng trong vật liệu, nó kết hợp với electron kế cận, thế thì hai hạt bị hủy và biến thành hai photon, tuân theo định luật bảo toàn động lượng và năng lượng.

- 1) Hai photon thì bay ra ngược chiều nhau.
- 2) Năng lượng của photon tương ứng với KL nghỉ của electron ($m_0c^2 = 511 \text{ keV}$).
- 3) Hai photon có sự khác biệt khoảng 10 eV, thế thì1) và 2) sẽ khác nhau chút ít do hiệu ứng Doppler effect.





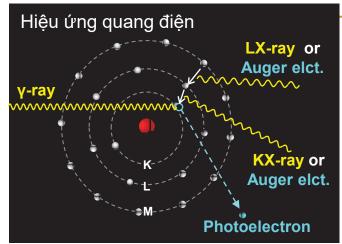
Hiệu ứng Cherenkov

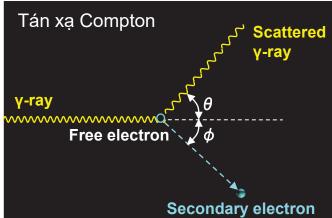
Khi electron mang NL cao với vận tốc v bay qua các chất điện môi (nước, kính, etc) và bị khúc xạ trong môi trường có chiết suất n, và ánh sánh rất yếu được phát ra, nếu v có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng (c/n) trong vật chất.

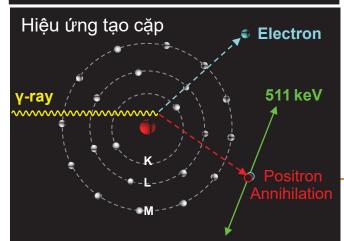
Ví dụ: nước (n=1.33), có năg lượng trung bình *) do hiệu ứng Cherenkov là 275 keV.

*) $E(\text{keV}) = 511\{ (1 - \beta^2)^{-1/2} - 1 \}$ với, $\beta = \text{v/c} = 1/\text{n}$ β -ray năng lượng cao (e.g. 2.28MeV từ ⁹⁰Y) được

ghi nhận ánh sáng yếu được phát ra hiệu ứng Cherenkov với PMT độ nhạy cao.







Tương tác của photon và electron thứ cấp

γ-ray để toàn bộ năng lượng trong electron lớp trong cùng, E_e được giải phóng. E_e = hv- B Một electron khác sẽ lấp đầy lỗ trống, khi đó X-ray đặc trưng hoặc electron Auger được sinh ra, e.g. $E_{\text{K-Auger}} = (B_{\text{K}} - B_{\text{L}}) - B_{\text{M}}$ Tiết diện ζ_{K} cho electron lớp K tỉ lệ với ; $Z^5(\text{hv})^{-3.5}$ với, Z là số điện tích.

Khi γ -ray để lại một phần NL E_e cho electron và tán xạ với góc θ với NL của γ -ray sau tán xạ hv'.

NL sau tán xạ được tính theo công thức.

$$hv' = hv / \{1 + \alpha(1 - \cos\theta)\}$$

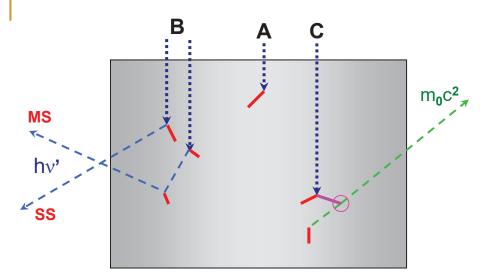
 $v\acute{o}i, \alpha = hv / m_0c^2$ $m_0c^2 = 511 \text{ keV}$
 $E_0 = hv - hv'$

Nếu γ-ray có năng lượng lớn hơn $2m_0c^2$ thì cặp electron và positron được sinh ra trong trường hạt nhân.

Tổng động năng của electron và positron ; $E_e + E_p = hv-2m_0c^2$

Positron, sau khi mất NL sẽ hủy với electron, và hai photons hủy với NL m₀c² (511 keV) được sinh ra.

Tương tác của gamma với vật chất



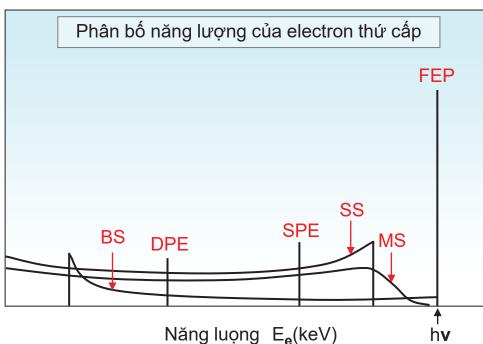
A) Hiệu ứng quang điện (FEP)

$$E_e = hv$$

B) Tán xạ Compton

 $E_e = hv - hv'$

SS, MS, BS: phân bố liên tục

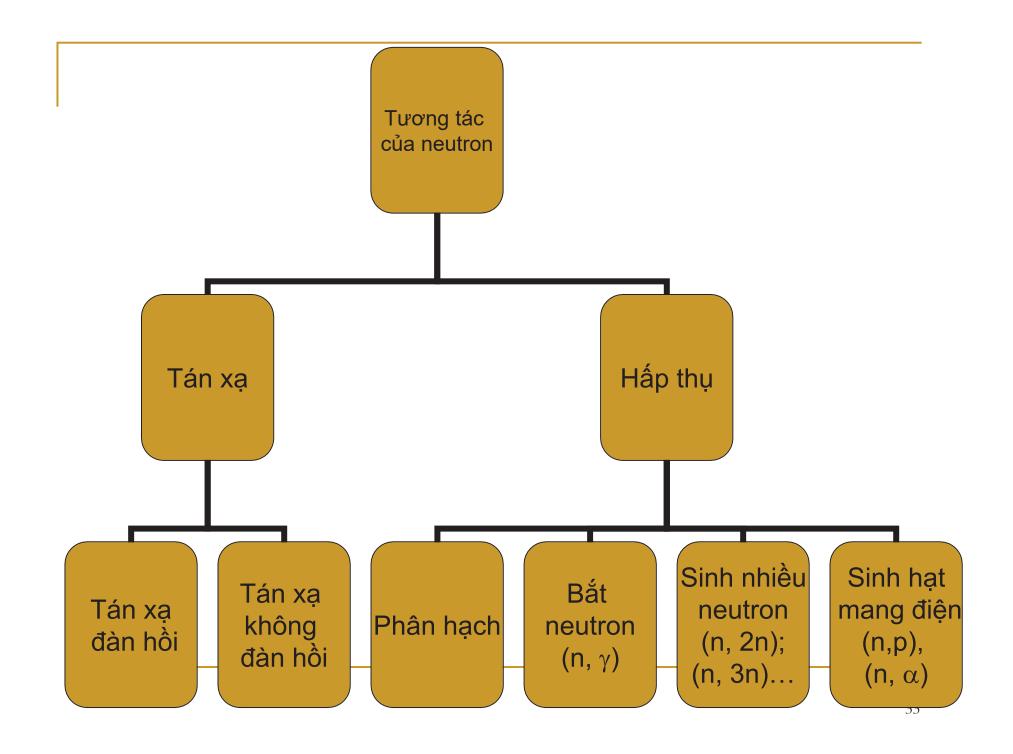


C) Hiệu ứng tạo cặp

$$E_e + E_p = hv - 2m_0c^2$$
 (m₀c² = 511 keV)

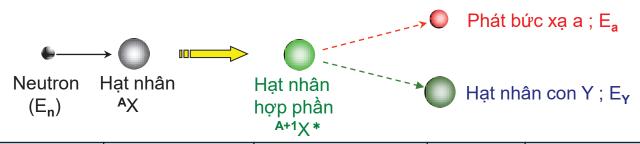
FEP = hv : Đỉnh gamma

SPE = hv- 511 : Đỉnh thoát đơn DPE = hv- 1022 : Đỉnh thoát đôi



Phản ứng HN trong ghi nhận Neutron

PUHN trên bia (X), X(n,a)Y, bức xạ(a) với động năng E_a được phát ra từ hạt nhân (Y) với động năng E_Y được sinh ra.

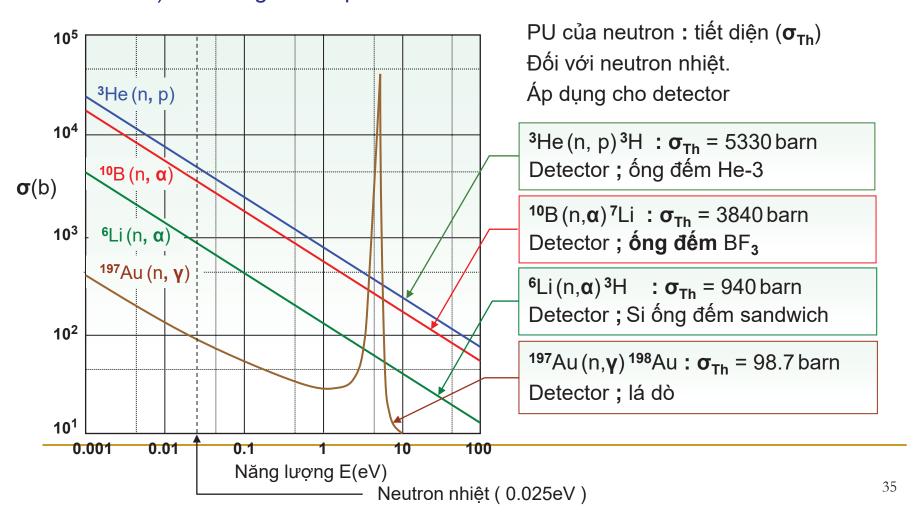


Loại phản ứng	Phản ứng	E(MeV)		ζ 1)	Neutron detector
	3 1 3	E _a	E _Y	(barn)	
Tán xạ đàn hồi	¹ H (n, n')p	0~E _n	$E_n \sim 0$	20 ~1 2)	proton detector 3)
Phản ứng sinh ra hạt mang điện	³ He (n, p) ³ H	0.574	0.191	5330	ống đếm He-3
	⁶ Li (n, <mark>α</mark>) ³ H	2.06	2.74	940	⁶ Li- Si ống đếm sandwich
	¹⁰ Β (n, <mark>α</mark>) ⁷ Li	1.47	0.84	3840	ống đếm BF ₃
Bắt neutron	$^{A}X(n,\gamma)^{A+1}X$	3 ~ 8	0	mb ~ kb	Lá dò
Phân hạch	²³⁵ U (n, f) FP	2FPs ~ 200		583	Buồng phân hạch

- 1) Ngoại trừ H (n, n') p, tiết diện đối với neutron nhiệt (0.025 eV).
- 2) Đối với $E_n = 0.1 \sim 5 \,\text{MeV}$, $\zeta(E_n)$ có thể xấp xỉ $4.2 \,E_n^{-0.55}$ (± 5%).
- 3) Ông đếm tỉ lệ, plastic hoặc nhấp nháy lỏng

Tiết diện tương tác của Neutron

Tiết diện tương tác của hạt nhân σ (đơn vị barn=10⁻²⁴cm²) là xác suất xảy ra tương tác trên một hạt nhân của bia Ví dụ., Tốc độ phản ứng (s⁻¹) = σ Nu Ở đây, N số hạt nhân trong bia and υ là mật độ thông lượng neutron (cm⁻² s⁻¹). Tiết diện phản ứng của neutron trong một số trường hợp tuân them quy luật (1/ v ~ 1/E^{1/2}) cho vùng NL thấp.



PU bắt neutron

PU bắt neutron, ${}^{A}X(n, y){}^{A+1}X$, hạt nhân con $({}^{A+1}X)$. Nếu hạt nhân con là đồng vị phóng xạ, thì PU trên dùng trong kích hoạt vật liệu.

Đặc trưng của PU bắt neutron

- 1) Hạt nhân bia có tiết diện lớn, ngoại trừ một số đồng vị nhẹ, bởi vì rào thế Coulomb và năng lượng tỏa ra của PU(Q>0)
- 2) Tiết diện tỉ lệ thuận với quy luật($v^{-1} \sim E^{-1/2}$), Do đó, neutron nhiệt được sử dụng trong nhà máy điện hạt nhân.
- 3) γ-ray năng lượng cao (3~8 MeV), được gọi là bắtγ-ray hoặc γ-ray tức thời.
- Hạt nhân con thừa neutron sẽ phan rã bằng cách phát β⁻ ray.

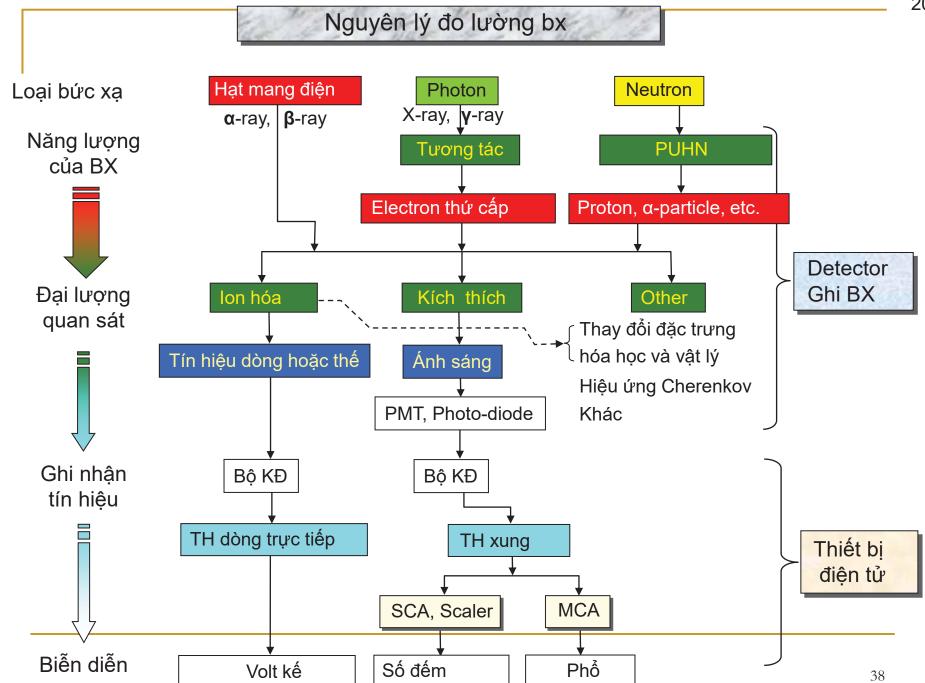
Ví dụ về PU bắt neutron

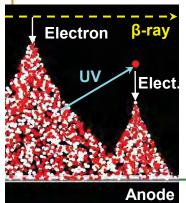
HN bia	HN con CKBR ¹⁾	σ _{Th} (barn)
¹H	² H (bền)	0.332
² H	³ H (12.33 y)	0.55 mb ²⁾
¹³ C	¹⁴ C (5730 y)	1.37 mb
²³ Na	²⁴ Na (14.96 h)	0.531
⁵⁹ Co	⁶⁰ Со (5.27 у)	37.2
⁹⁸ Mo	⁹⁹ Mo (65.9 h)	0.13
133Cs	¹³⁴ Cs (2.07 y)	29
¹⁵¹ Eu	¹⁵² Eu (13.54 y)	5900
191 r	¹⁹² lr (73.83 d)	309
¹⁹⁷ Au	¹⁹⁸ Au (2.694 d)	98.65

- 1) Đơn vị h:hour d:day y:year
- 2) Đây là chất làm chậm neutron tốt nhất

Pặc diễm của detector do bức xạ

Nguyên lý ghi nhận BX Đặc trưng của sự ion hóa chất khí Buồng ion hóa, ống đếm tỉ lệ và ống đếm Geiger-Mueller (GM) Nguyên lý của detector bán dẫn Nguyên lý nhấp nháy Đặc trưng của chất nhấp nháy





Đặc trưng của sự ion hóa chất khí

Cơ chế của ghi nhận BX bằng sự ion hóa chất khí (buồng ion hóa, ống đếm tỉ lệ và ống đếm GM) là đặc trưng của quá trình ion hóa như sau

A) Miền buồng ion hóa

Các electron và ion dương sinh ra do quá trình ion hóa được kéo về mỗi điện cực mà không bị tái hợp.

Thế thì, tín hiệu ra sẽ tỉ lệ với số cặp electron-ion bởi quá trình ion hóa ban đầu.

B) Miền ống đếm tỉ lệ

Các electron được gia tốc trong điện trường (~10⁵ V/cm) và ion hóa cá nguyên tử trung hòa trong chất khí khi kéo về cực dương.

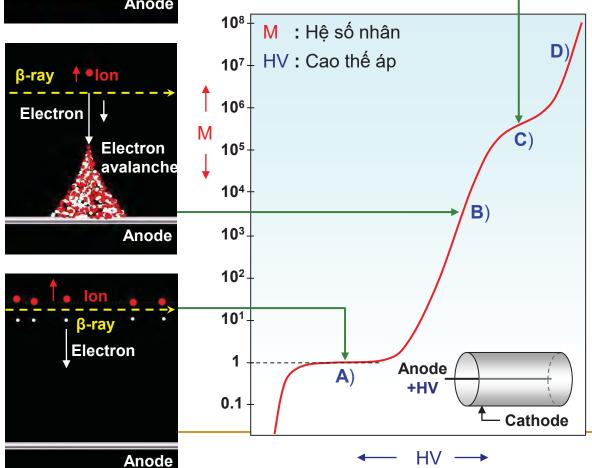
Quá trình này được gọi thác lũ electron. Tín hiệu ra được bổ sung từ vài trăm đến hàng ngàn lần

C) Miền ống đếm GM

Tia cực tím (UV) từ nguyên tử bị kích thích, hiệu ứng thác lũ lại sinh ra cặp electron-ion một lần nữa, trên toàn bộ cực dương.

Trong ống đếm GM, có một số chất khí được gọi là khí dập tắt được đưa vào để triệt tiêu sự phóng điện liên tục.

D) Miền phóng điện liên tục Óng đếm không là việc hoặc bị đánh thủng.



Đặc trưng của detector bán dẫn

Detector bán dẫn Si có thể vận hành ở nhiệt độ thường bởi vì độ rộng vùng năng lượng lớn. Do đó, thường được sử dụng cho đo các hạt mang điện, nhưng không phù hợp để đo photon có năng lượng lớn hơn 20keV.

Detector bán dẫn Ge phải làm lạnh ở nhiện độ của N lỏng (77K = -196°C), độ rộng vùng năng lượng nhỏ (0.665 eV), được dùng trong đo đạc photon có độ rộng từ (keV~MeV).

Detector bán dẫn hợp chất được dùng đo photon nhỏ hơn 100keV, bởi vì kích thước tinh thể nhỏ và giá trị µxmhỏ.

Bán dẫn	Số Z E _q (eV)		ε(eV)	Độ lđ µ(cm ² ·V ⁻¹ ·s ⁻¹)		thời gian sống η (s)	
		_g (0 v)	, ,	Electron	Pos. hole	Electron	Pos. hole
Si	14	1.12	3.61	1500	600	3 x10 ⁻³	3 x 10 ⁻³
Ge	32	0.67	2.96	3900	1800	1 x10 ⁻³	1 x10 ⁻³
GaAs	31, 33	1.43	4.27	8500	420	1 x10 ⁻⁷	1 x10 ⁻⁷
CdTe	48, 52	1.5	4.43	1000	80	1 x10 ⁻⁶	1 x 10 ⁻⁶
Hg I ₂	80, 53	2.1	4.15	100	4	1 x10 ⁻⁷	1 x 10 ⁻⁸

Z: Có khả năng ghi nhận photon do hiệu ứng quang điện

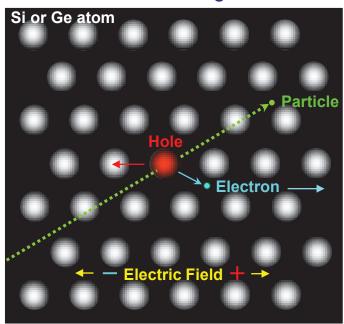
 $\mathsf{E_g}$: Độ rộng vùng nghèo, nhiễn do nhiệt thấp và có thể đo ở nhiện độ phòng

E: Năng lượng trung bình tạo ra cặp electron & lỗ trống dương

μχη: Giá trị càng lớn càng thuận lợi cho quá trình thu thập điện tích Vận tốc thu thập: v (cm·s-¹) =μ(cm ²·V -¹·s-¹) x F (V·cm-¹) với, F là lực điện.

Nguyên lý của detector bán dẫn

Quá trình ion hóa trong chất bán dẫn

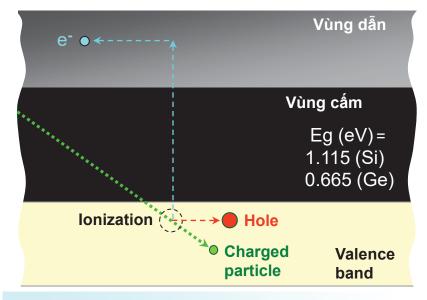


Sinh electron và lỗ trống dương

Hạt mang điệng (electron nhanh, etc) sinh ra nhiều cặp electron-lỗ trống dương bởi quá trình ion hoa nguyên tử Ge. Electrons được kéo về anode do lực điện trường,nhưng dương ions được giữ lại trong mạng tinh thể

Nếu áp điện trường vào bán dẫn thì electron của nguyên tử trung hòa kế cận sẽ lấp đầy và nuyên tử lại trở thành ion dương.

Quán trình này làm cho các hạt mang điện dương (lỗ trống) di chuyển về phía cực âm.

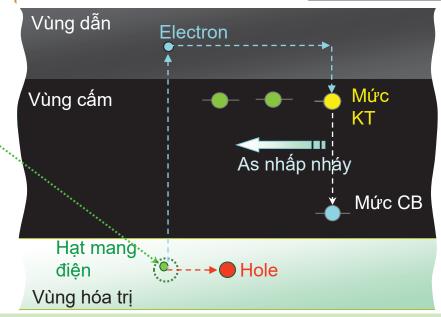


Do độ rông vùng nghèo nhỏ Ge, tinh thể Ge phải được làm lạnh ở T = 77K.

Khi động năng (E) của electoron thứ cấp bị gấp thụ trong vùng nhạy của tinh thể Ge, Số cặp (N) of electron-lỗ trống được sinh ra là N = Ε/ε.

Với, ε là 2.96 eV năng lượng trung bình sinh ra nhiều cặp electron-lỗ trống dương Ge. Full width at half maximum (FWHM) bề rộng một nửa chiều cao; FWHM = 2.355 (FεΕ)^{1/2} Ở đây, F là hệ số Fano (F≈ 0.1).

Nguyên lý nhấp nháy

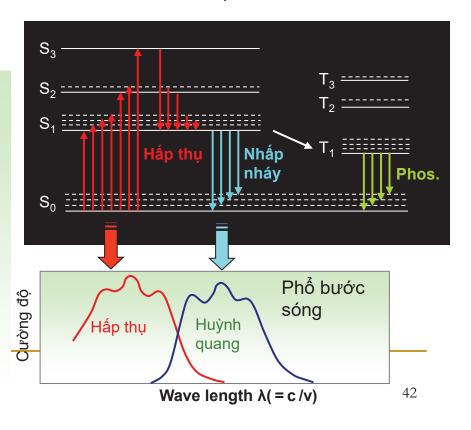


Nhấp nháy vô cơ

- 1) Một số lượng lớn cặp electron và lỗ trống được tạo ra ở vùng hóa trị sau khi hấp thụ bức xạ.
- 2) Lỗ trống dương bắt các electron từ các nguyên tử hoạt động có mức năng lượng ion hóa thấp hơn và trở thành nguyên tử trung hóa.
- Các electron trong vùng dẫn thì bắt các nguyên tử hoạt động trong trạng thái kích thích.
- 4) Các nguyên tử hoạt động quay về trạng thái cơ bản sau thời gian sống ở trạng thái kích thích và phát ra ánh sáng khả kiến

Nhấp nháy hữu cơ

- Các phân tử nhấp nháy sẽ dịch chuyển lên mức kích thích (S₁, S₂, S₃), sau khi hấp thụ NL bức xạ.
- 2) Sau khi tồn tại cỡ ps, chúng sẽ dịch chuyển xuống mức NL thấp hơn.
- 3) Sau đó cỡ ns, Chúng dịch chuyển về mức cơ bản kèm theo phát as khả kiến.



300

 $I = I_1 e^{-t/\tau_1} + I_2 e^{-t/\tau_2}$

 I_2 , T_2

t (ns)

100

200

Đặc trưng của chất nhấp nháy

Đặctrưng vật lý của chất nhấp nháy

	_	-		-	-			
Nhấp nháy	ρ g/cc	Rel. SNS	λ max (nm)	τ ₁ (ns)	HYG			
	Nhấp nháy hữu cơ							
Plastic	1.03	30 ±3	420 ±10	2.4 ±0.5	No			
Lỏng	0.88	30 ±3	420 ±10	2.5 ±0.5				
	Nh	ấp nháy	/ vô cơ					
Nal(TI)	3.67	100	415	230	Yes			
CsI(TI)	4.51	45	565	1000	Low			
CsI(Na)	4.51	85	420	630	Yes			
ZnS(Ag)	4.09	130	450	70	No			
BGO	7.13	12	480	300	No			



T₁: hằng

CƯờng độ tương đối

.001



Bột phủ

 $BGO: Bi_4Ge_3O_{12}$ LSO: Lu_2SiO_5 (Ce) YAP: YAIO₃(Ce)

76

40

166

420

347

380

40

28

16

No

No

Yes

 ρ : mật độ (g/cm³) Rel.SNS : Độ nhạy tương đốiNal(Tl) λ_{max} : bước sóng cực đại (nm)

7.35

5.55

5.29

LSO

YAP

LaBr₃(Ce)

số phân rã (ns) HYG: Hút ẩm tự nhiên

Ghi nhận α-ray, β-ray và photon

- ⊚ ghi nhận phổ
 thích hợp
 ◇ đo liều

Nguyên lý	Detector	α-ray	β-ray NL thấp	β-ray	Photon NL thấp	Photon
Chất khí	Buồng ion hóa	Δ	Δ	Δ	Δ	♦
Chat Kili	OD tỉ lệ	0	Δ	0	Δ	Δ
	OD GM	Δ×	△ ×	0	Δ	♦
Bán dẫn	Detector Si	0	0	Δ	0	♦
	detector Ge	×	×	×	0	0
Nhấp nháy	Plastic	0	0	0	Δ	0
	Lỏng	0	0	0	Δ	Δ
	Nal(TI)	×	×	×	0	0
	ZnS(Ag)	0	×	×	×	×
	BGO	Δ	×	×	Δ	0

Đại lượng đo liều

Liều hấp thụ



Liều tương đương

(Trọng số bức xạ, w_R)



Liều hiệu dụng

(Trọng số mô, w_T)

I C R P

International Commission on Radiological Protection

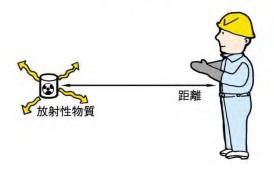
ICRP 60 (1990) và ICRP 103 (2011)

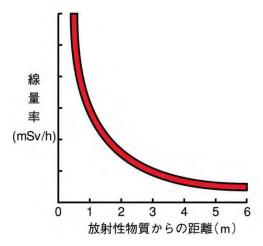
The Three Key Points of the ICRP's Recommendations

- Justification. No practice should be adopted unless its introduction produces a positive net benefit.
- Optimization. All exposures should be kept As Low As Reasonably Achievable (ALARA), economic and social factors being taken into account.
- **Limitation**. The exposure of individuals should not exceed the limits recommended for the appropriate circumstances.

An toàn phóng xạ

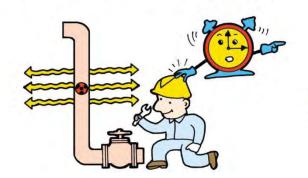
Khoảng cách

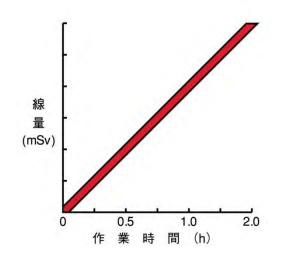




Thời gian

[線量]=[作業場所の線量率]×[作業時間]





Che chắn

